

## Содержание

**Еремин В.К., Фадеева Н.Н., Вербицкая Е.М., Еремин И.В.**

Физическое обоснование предела временного разрешения кремниевых планарных детекторов длиннопробежных тяжелых ионов . . . . . 333

- XXVIII Международный симпозиум „Нанопфизика и наноэлектроника“, Нижний Новгород, 11–15 марта 2024 г.

**Кукушкин В.А., Кукушкин Ю.В.**

Потенциальное быстроедействие алмазного полевого транзистора на приповерхностном двумерном дырочном газе . . . . . 283

- Электронные свойства полупроводников

**Давидович М.В.**

К электродинамике полупроводниковых магнитоплазменных волноводов . . . . . 288

- Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

**Марков Л.К., Смирнова И.П., Павлюченко А.С., Яговкина М.А., Аксенова В.В.**

Модификация структуры нанокристаллических пленок оксида индия и олова . . . . . 297

**Лебедев М.В., Львова Т.В., Седова И.В., Королева А.В., Жижин Е.В., Лебедев С.В.**

Пассивация поверхностей AlGaAs(100) растворами сульфидов аммония . . . . . 302

- Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

**Харченко А.А., Надточий А.М., Шерняков Ю.М., Гордеев Н.Ю., Паюсов А.С., Бекман А.А., Корнышов Г.О., Симчук О.И., Салий Ю.А., Кулагина М.М., Минтаиров С.А., Калужный Н.А., Максимов М.В.**

Оптическое усиление в волноводных гетероструктурах спектрального диапазона 1010–1075 нм с активной областью на основе InGaAs квантовых яма-точек . . . . . 313

**Бабицев А.В., Надточий А.М., Блохин С.А., Неведомский В.Н., Крыжановская Н.В., Бобров М.А., Васильев А.П., Малеев Н.А., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Егоров А.Ю.**

Исследование структурных и оптических свойств InGaAs-квантовых точек . . . . . 318

- Физика полупроводниковых приборов

**Кардо-Сысоев А.Ф., Черенёв М.Н., Люблинский А.Г., Смирнова И.А., Юсупова Ш.А., Беякова Е.И., Векслер М.И.**

Влияние внешних параметров на процесс переключения при задержанной ионизации в кремниевой  $p^+-n-n^+$ -структуре . . . . . 326